

7A、600V N沟道增强型场效应管

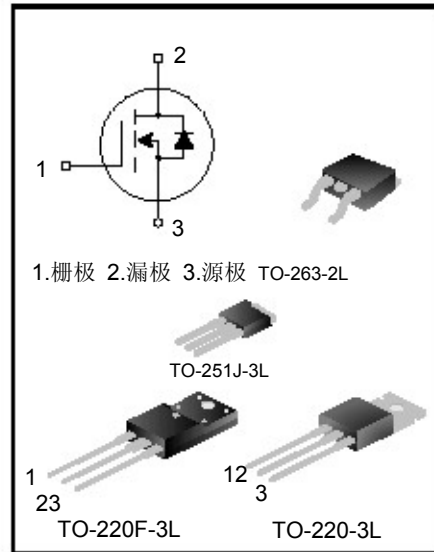
描述

SVF7N60T/F/S/MJ N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用SL电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

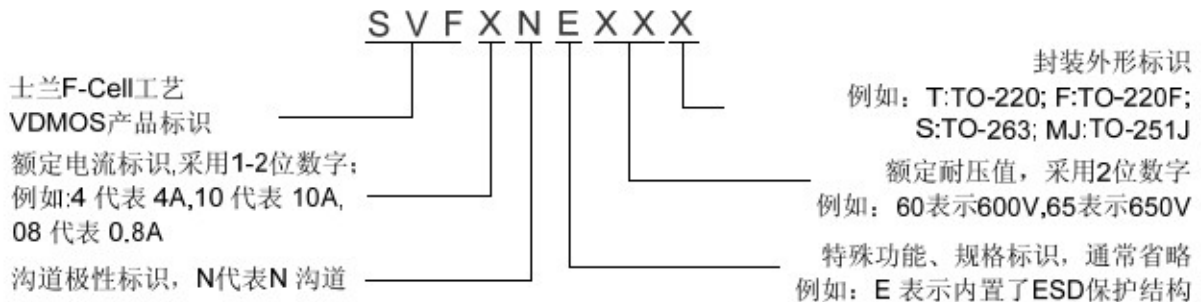
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 7A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=1.0Ω@ $V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装形式
SVF7N60T	TO-220-3L	SVF7N60T	无铅	料管
SVF7N60F	TO-220F-3L	SVF7N60F	无铅	料管
SVF7N60S	TO-263-2L	SVF7N60S	无铅	料管
SVF7N60STR	TO-263-2L	SVF7N60S	无铅	编带
SVF7N60MJ	TO-251J-3L	SVF7N60MJ	无铅	料管



SVF7N60T/F/S/MJ 说明书

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF7N60T/MJ	SVF7N60F	SVF7N60S	
漏源电压	V_{DS}	600			V
栅源电压	V_{GS}	± 30			V
漏极电流	I_D	$T_c=25^\circ\text{C}$			A
		7.0			
		$T_c=100^\circ\text{C}$			
		4.0			
漏极冲击电流	I_{DM}	28			A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	145	45	140	W
		1.16	0.36	1.12	W/ $^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	489			mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$			$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$			$^\circ\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数范围				单位
		SVF7N60T	SVF7N60F	SVF7N60S	SVF7N60MJ	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.86	2.78	0.89	0.82	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	120	62.5	110	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu\text{A}$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$	--	1.0	1.2	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHZ}$	--	915	1430	pF
输出电容	C_{oss}		--	104	175	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.34	21	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=7.0A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2,3)	--	27.33	60	ns
开启上升时间	t_r		--	58.40	70	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	42.13	300	
关断下降时间	t_f		--	31.20	90	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=7.0A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2,3)	--	15.16	37	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	5.08	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	4.95	--	



源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的 反偏 P-N 结	--	--	7.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	28	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=7.0A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	365	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	3.4	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=5.16A, V_{DD}=159V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

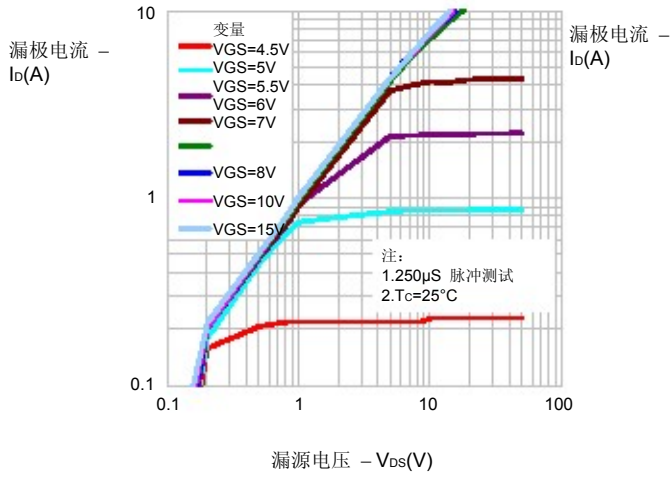


图2. 传输特性

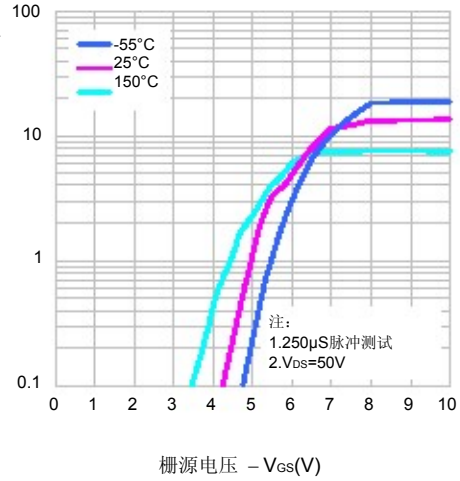


图3. 导通电阻vs.漏极电流

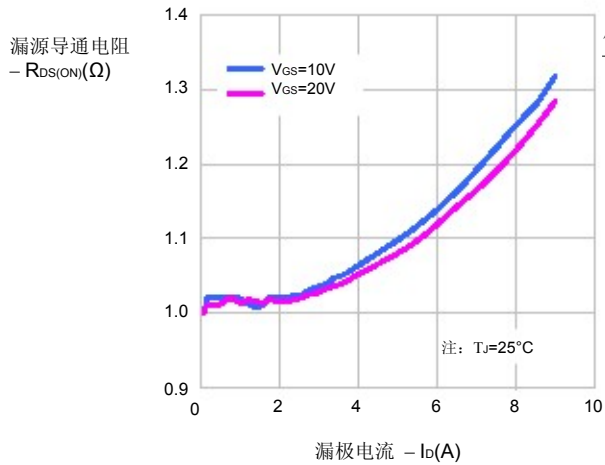


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

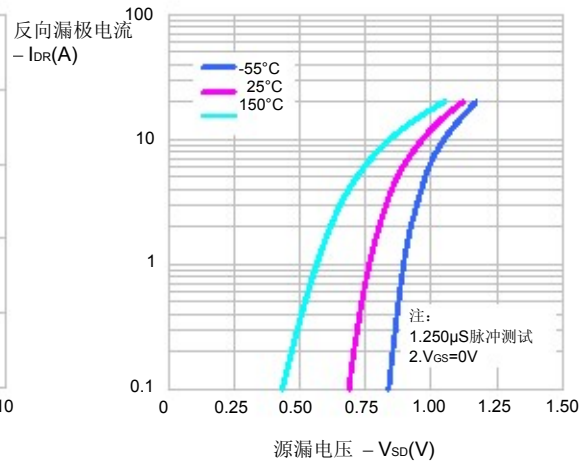


图5. 电容特性

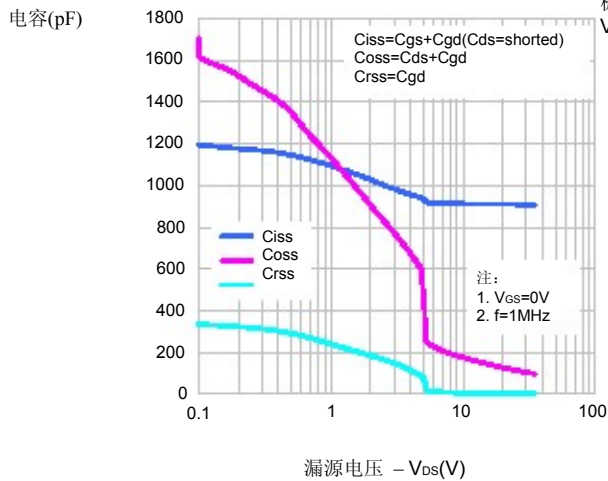
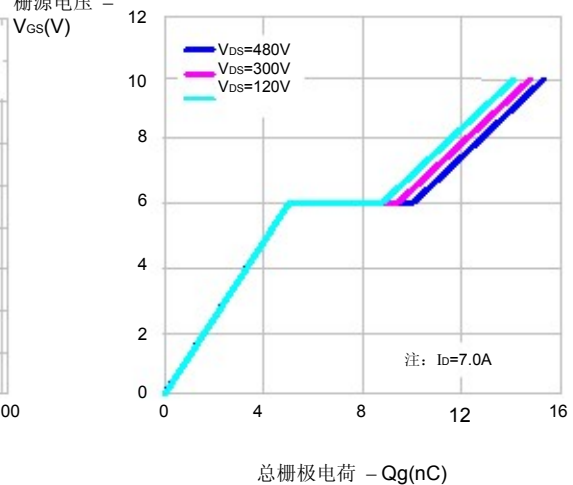
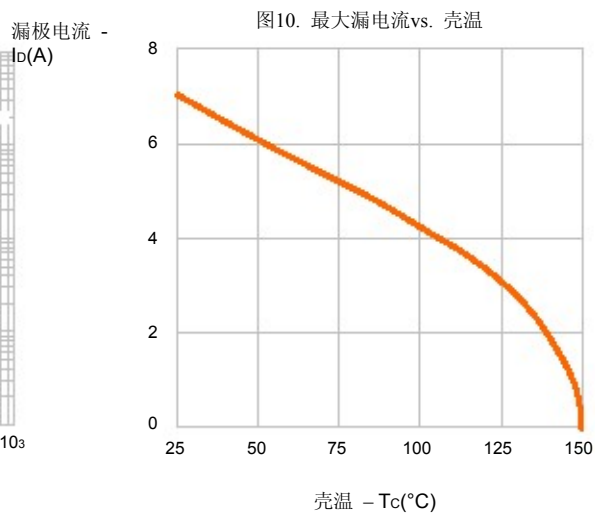
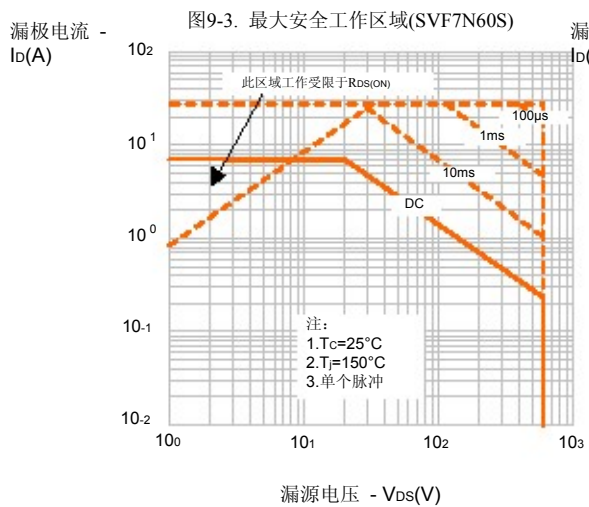
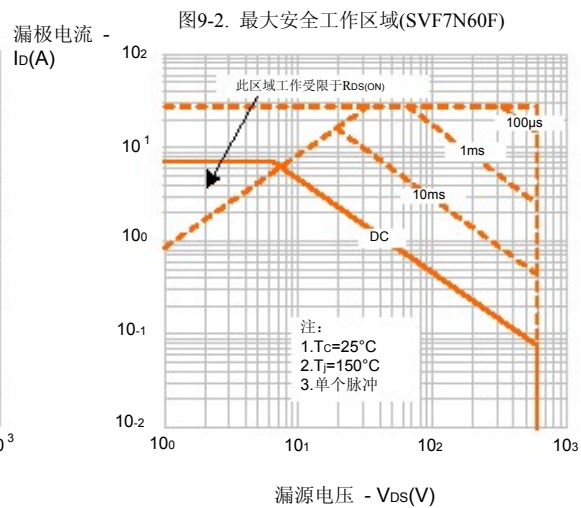
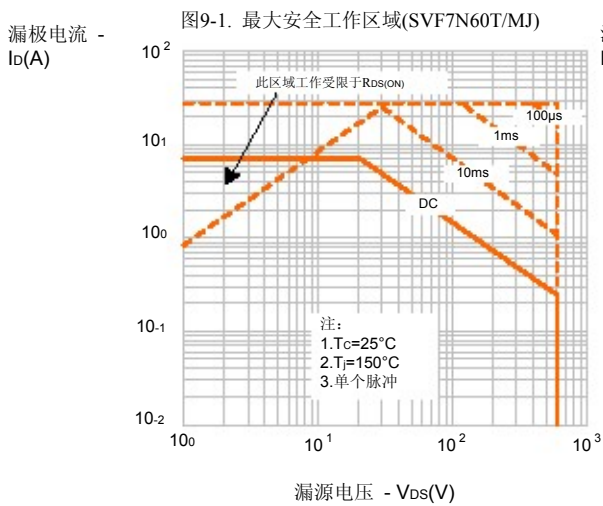
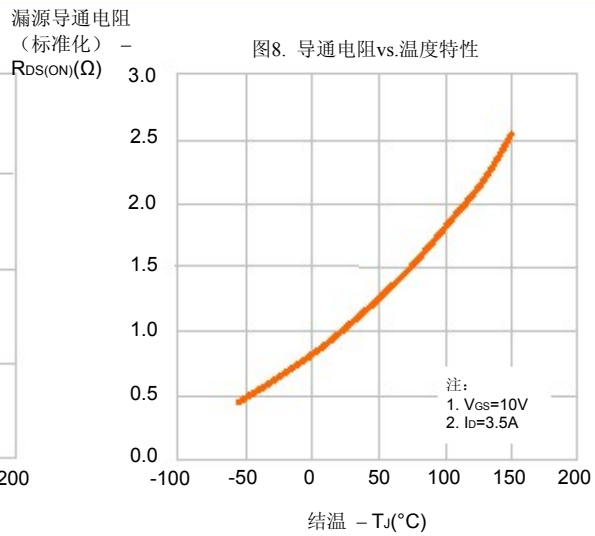
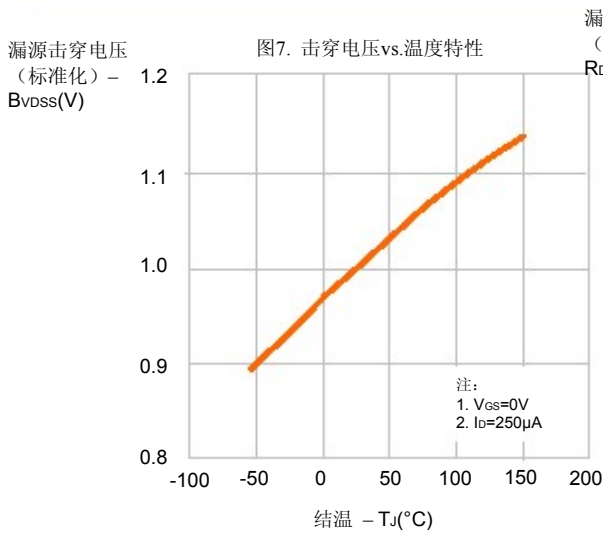


图6. 电荷量特性





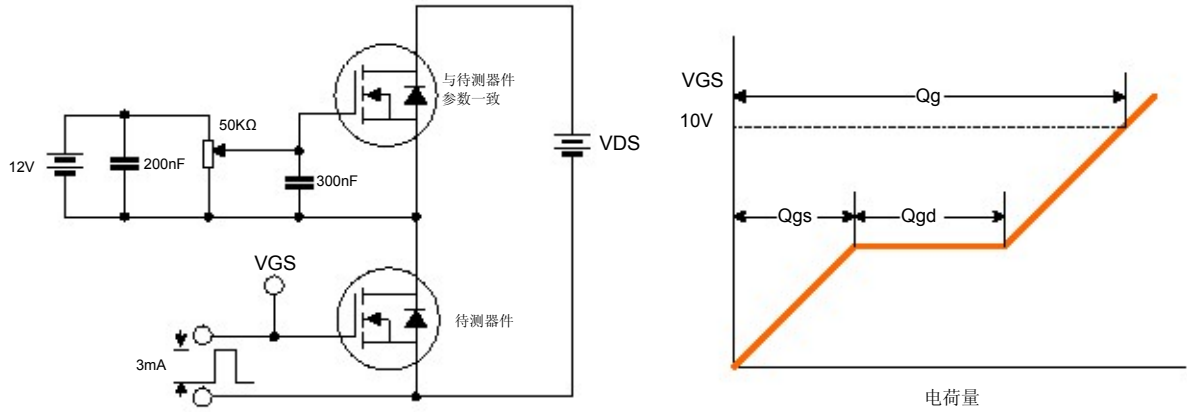
典型特性曲线 (续)



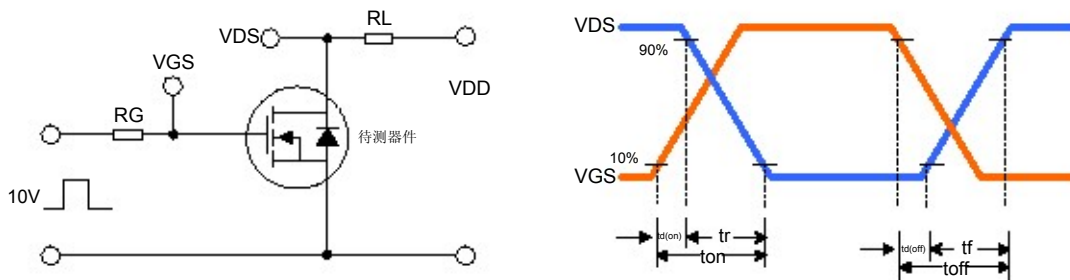


典型测试电路

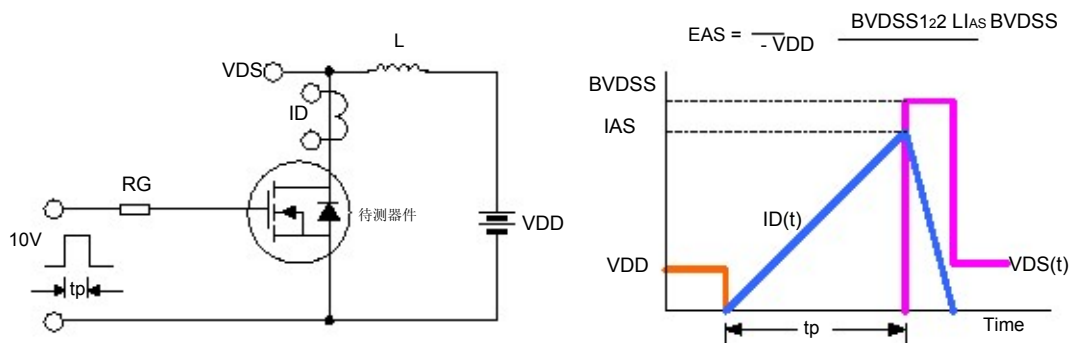
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

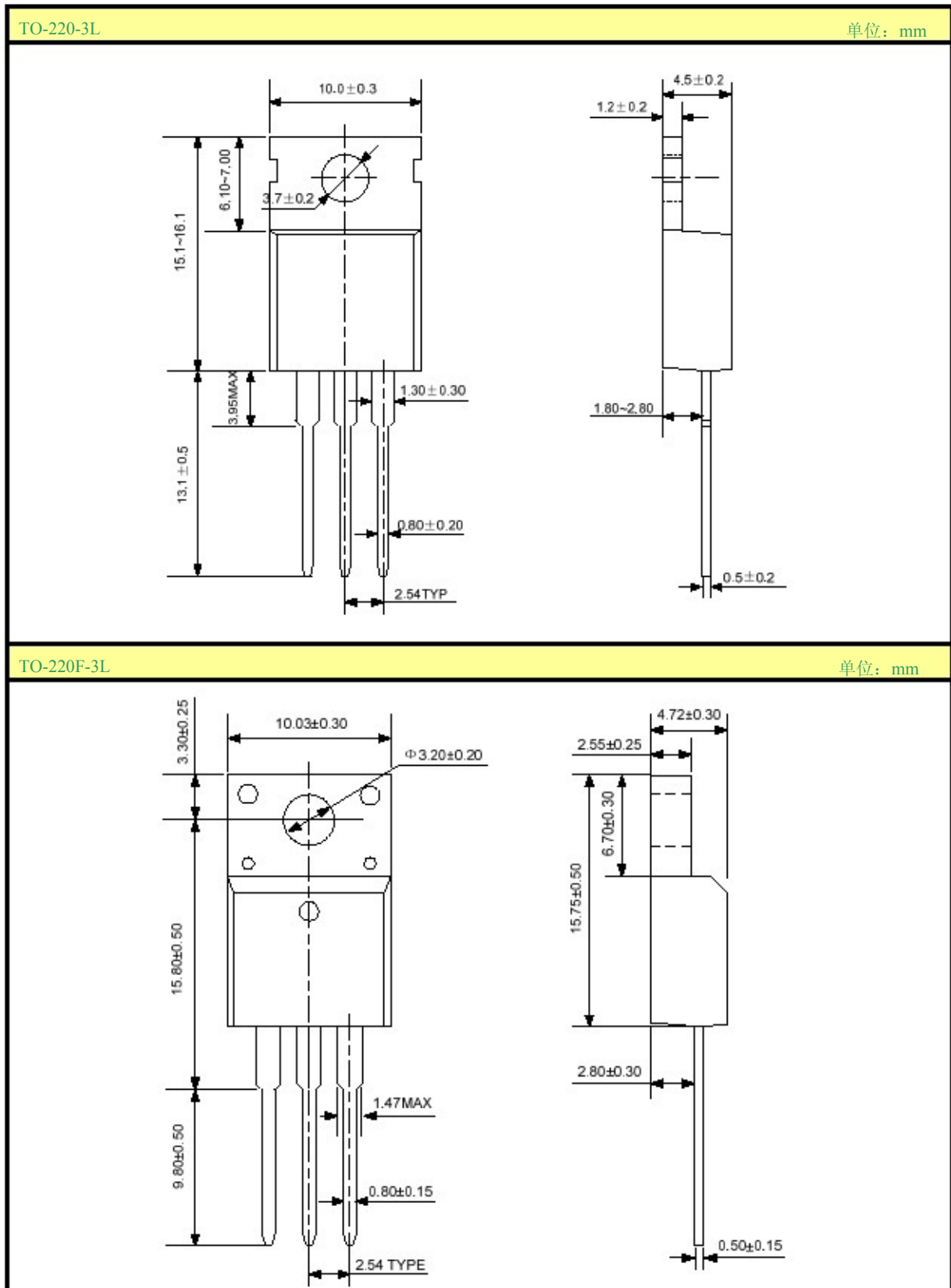


EAS测试电路及波形图



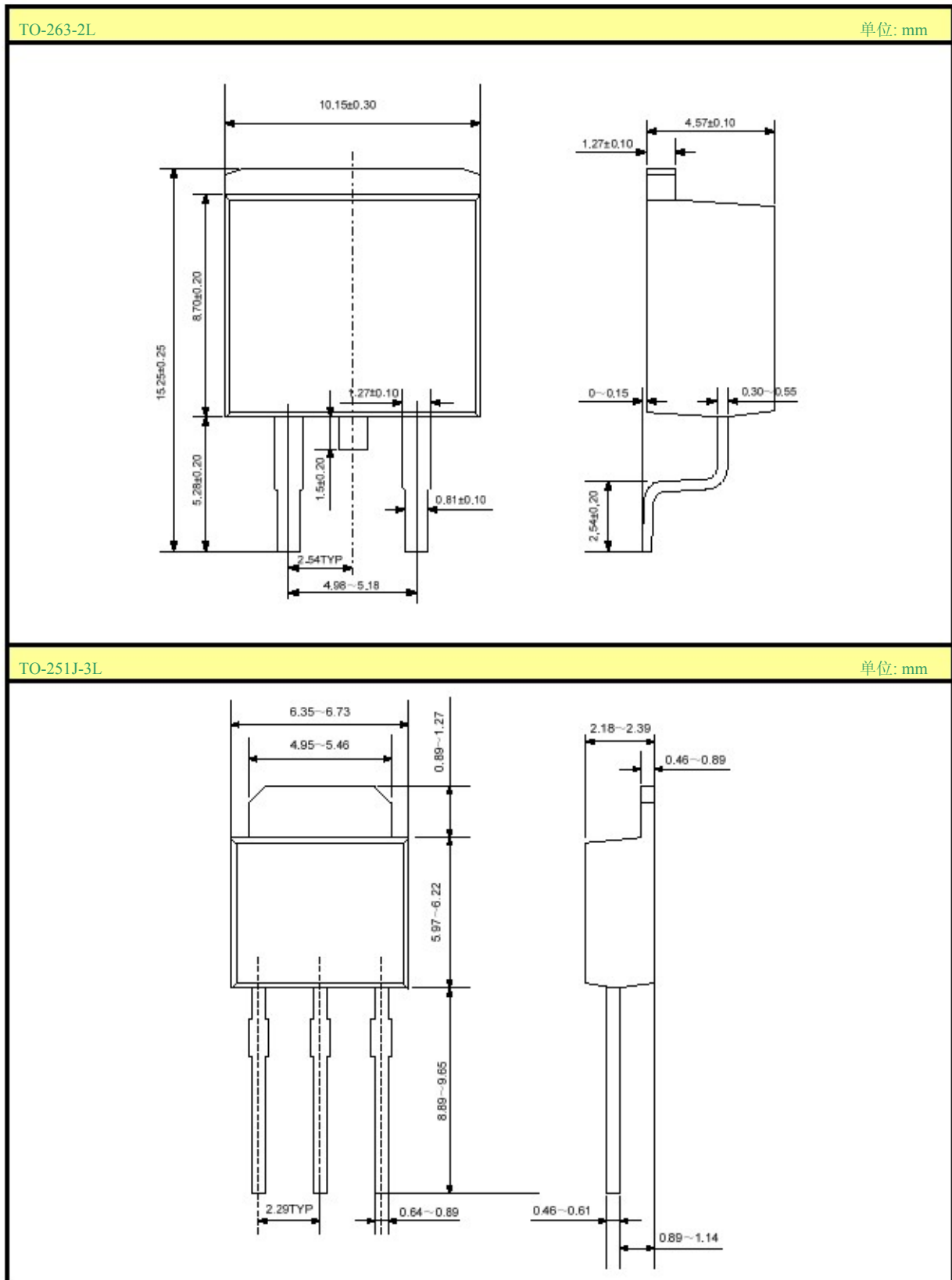


封装外形图





封装外形图 (续)





SVF7N60T/F/S/MJ 说明书

声明:

- SL保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页码
2011.01.17	1.0	原版	
2011.05.17	1.1	增加TO-263-2L封装	
2011.07.04	1.2	更新TO-220F-3L尺寸图	7
		增加TO-251J-3L封装	8
2011.09.15	1.3	更新TO-220-3L尺寸图	7

SL一级授权总代理: 昆山东森微电子有限公司

手机: 15950933050

电话: 0512-50710709

传真: 0512-50111209

MSN: wei_126@hotmail.com

Q Q: 41086900

网站: <http://www.ksmcu.com>